

2012年11月22日

先端理工学専攻各位

主任： 安江常夫

世話人：安江常夫

大学院ゼミナールのご案内

以下のように大学院の特別講義を開催しますので、ご案内致します。
院生は必修ですので、必ず出席して下さい。

1. 日時：2012年12月11日（火）午後5時より
2. 場所：J-514
3. 講師：重田諭吉教授（副学長）横浜市立大学生命ナノシステム科学研究科
4. 題目：Ge(111)およびSi(111)面上の金属2次元状態の歪みによる変化
5. 要旨

SiGe系を利用した歪みシリコンによるトランジスターの高速化に見られる様に、結晶構造と電子状態は密接に関係しており、電子物性の制御において構造との関係が非常に重要になっている。セミナーでは、Si(111)表面やGe(111)表面にAgを1層吸着して形成される $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ -Ag構造の金属2次元状態の有効質量が歪みの導入によりどのように変化するか、実験手法も含め解説したい。

以上